

Information Disclosure Statement

New U.S. PCT National Phase Application
Your Ref. No.: 123037-05026075
Our Ref. No.: P03E8001/US/jy

Issued Date by the Korean Intellectual Property Office: February 21, 2005
Received Date from the Korean Intellectual Property Office: February 22, 2005

Reference No.: (1) KR Patent Laid-Open No. 2002-0045914

Best Available Copy

TITLE: *Radiation device for planar inverted F antenna*

This application was preliminarily rejected pursuant to Article 63 of the Korean Patent Law based on the following reason. Should there be any opinion against this action, please file a written argument by April 21, 2005. (You can apply for 1-month extension per each case, and we do not notify you of the confirmation for such term extension.)

[REASON]

This invention described in claims 1 to 3 can be easily invented by those skilled in the art as pointed out below. Accordingly, the above-identified patent application cannot be registered pursuant to Article 29, Paragraph 2 of the Korean Patent Law.

[BELOW]

Claims 1 to 3 of the present invention are directed to a radiation device for planar inverted F antenna having a taper structure.

Meanwhile, Korean Patent Laid-Open No. 2002-0045914, which will be referred to as a reference hereinafter, discloses an antenna with a structure modified from a planar inverted F antenna.

In comparison with the cited reference, the antenna of the present invention is considered to be similar to that of the reference in that the antenna characteristics are improved by changing the external structure of a radiation device. If any difference, the antenna of the present invention has a taper shape. However, it is considered that the different structure can be designed and modified by those of ordinary skill in the art. Accordingly, claims 1 to 3 of the present invention are thought to be easily invented by those skilled in the art from the cited reference.

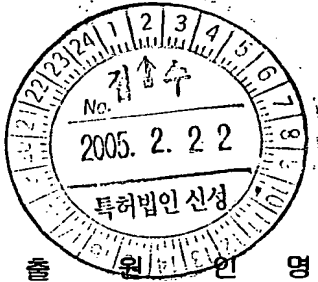
*[Attachment] 1. KR Patent Laid-Open No. 2002-0045914
 (Published on June 20, 2002)*

PO2E8001

발송번호: 9-5-2005-007651000
발송일자: 2005.02.21
제출기일: 2005.04.21

수신 서울시 강남구 역삼동823-30라인빌딩2,3층
특허법인 신성

135-080



특 허 청 의견제출통지서

PO2E8001/US

출 원 인 명 칭 한국전자통신연구원 (출원인코드: 319980077638)
주 소 대전 유성구 가정동 161번지
대 리 인 명 칭 특허법인 신성
주 소 서울시 강남구 역삼동823-30라인빌딩2,3층

출 원 번 호 10-2002-0051039
발 명 의 명 칭 평면형 역 에프 안테나용 방사체 및 이를 이용한 평면형역
에프 안테나

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제3항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

본 발명의 청구범위 제1항 내지 제3항(이하 본원이라함)은 평면형 역에프 안테나의 방사체가 끝이 좁아지는 테이퍼 형상으로 구성되는 것을 특징으로 하고 있습니다.

한편, 공개특허 2002-0045914호(이하 인용발명이라함)는 평면형 역에프 안테나의 방사체를 구조적으로 변형시킴으로서 안테나의 특성을 변화시키는 것을 개시하고 있습니다.

본원과 인용발명을 비교하여 보면, 방사체의 구조적인 모습을 변화시켜 특성을 개선하는 것은 인용발명과 유사하다고 판단되며, 단지 그 구조적인 모습이 본원은 테이퍼형상이라는 것 이지만 상기의 차이는 당업자라면 일상적으로 설계하여 변경할 수 있는 것이라 판단됩니다.

이에 본 발명의 청구범위 제1항 내지 제3항은 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[참 부]

첨부1 공개특허 제2002-45914호(2002.06.20) 1부. 끝.

특허청

2005.02.21
전기전자심사국
통신심사담당관실

심사관

이상돈



심사관

전기억



<< 안내 >>

명세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허법·실용신안법·의장법및상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-5706 로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터 ☎1544-8080으로 문의하시기 바랍니다.

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number: 1020020045914 A
(43)Date of publication of application: 20.06.2002

(21)Application number: 1020000075332

(22)Date of filing: 11.12.2000

(51)Int. Cl. H01Q 1/27

(71)Applicant: HUNETEC CO., LTD.

(72)Inventor: YOON, YEONG HAN

(54) MINI ANTENNA DEVICE USING MEDIUM WHICH HAS DIELECTRIC CONSTANT

(57) Abstract:



PURPOSE: A mini antenna device using medium which has dielectric constant is provided to perform a highly sensitive mini antenna for ISM (industrial scientific and medical equipment) band by setting up a medium which has a dielectric constant in a PIFA(planar inverted F antenna).

CONSTITUTION: An RF(radio frequency) signal process unit amplifies an RF signal and processes a filtering. A power supply unit(101) transmits a high-frequency signal from the RF signal process unit into an antenna unit. A short circuit unit(102) modifies a property impedance of an antenna. A radiation patch(100) performs an RF signal radiation. A medium(200) which has a dielectric constant over one decreases the size and height of the radiation patch (100).

© KIPO 2003

Legal Status

Date of final disposal of an application (20021001)

공개특허 제2002-45914호(2002.06.20) 1부.

[첨부그림 1]

특2002-0045914

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

| | |
|--|--|
| (51) Int. Cl. ⁷ H01Q 1/27 | (11) 공개번호 (43) 공개일자 |
| (21) 출원번호 (22) 출원일자 (71) 출원인 (72) 발명자 (74) 대리인 | 특2002-0045914 2002년 06월 20일 10-2000-0075332 2000년 12월 11일 주식회사 휴네텍 유영한 경기도 성남시 분당구 수내동 16-7 휴넷빌딩 10층 유영한 경기도 성남시 분당구 구미동 266-2 이동모 |

심사청구 있음

(54) 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치

요약

본 발명은 휴대용 통신기거나 산업용 무선 통신기기에 있어, 제품내 설장을 하기 위하여 PIFA(Planar Inverted F Antenna)방식의 안테나를 구현함에 있어 소형화와 더불어 슬림화를 가능케 하고 또한 안테나 자체로서 가져야 할 RF 이득과 대역폭 그리고 방사패턴을 가지도록 하기 위한 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치에 관한 것으로,

일반적 PIFA구조에 유전율을 가진 매체를 부설하고, 최상, 심호 전류길이를 길게 하기 위한 방사패치의 구조로 설계함으로써, 소형의 고감도 ISM(Industrial Scientific and Medical Equipment)밴드용 안테나를 구현할 수 있으며, 특히 이러한 소형화와 슬림화에 의해 통신기내나 시스템 기기내에 내장(Built-in)할 수가 있으므로, 종래의 모노폴 형태와 플록형 안테나가 가지던 문제점인 파손의 위험이나, 안테나부문의 공간적 한계 등을 극복할 수 있으며, 최종 제품의 외관이나 디자인 면에 있어도 보다 효과적인 결과를 가져올 수 있다.

도면

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

- 도 1은 본 발명의 PIFA방식 안테나 전체 구조도
 - 도 2는 종래의 일반적인 PIFA의 구조도
 - 도 3은 본 발명의 PIFA의 단락회로 길이에 따른 전류 분포도
 - 도 4는 본 발명의 패치(Top-plate)상의 시간에 따른 전류분포도
 - 도 5는 본 발명의 설 제작된 PIFA의 네트워크 분석기를 통해 측정한 실측값
 - 도 6은 본 발명의 시뮬레이션상에 나타난 방사 패턴도
- [도면의 주요부분에 대한 부호의 설명]
- 100 : 안테나 방사 패치 101 : 급전부
 - 102 : 단락부 200 : 유전체
 - 300 : RF PCB 기판 301 : RF 부품배치영역

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 ISM(Industrial Scientific and Medical Equipment)밴드에서의 사용될 수 있는 소형 PIFA(Planar Inverted F Antenna, 평면 역 F 안테나)에 관한 것으로, 일반적 PIFA구조에 유전율을 가진 매체를 부설함으로써, 소형화, 슬림화 가능케 하고 우수한 안테나의 이득과 대역폭 그리고 방사패턴을 가지도록 하는 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치에 관한 것이다.

PIFA방식의 안테나는 안테나의 크기를 소형화 할 수 있고 내장형(Built-In-Type)으로 구현 가능함으로 휴대용 통신 기기나 이동통신용 기기에 채용이 가능하며, 90년도 말부터 유럽의 GSM 휴대폰에 채용되고 있는 실정이다.

PIFA, 안테나와 관련한 선행기술을 보면 스웨덴 특허 SE 9702659-5, Compact Antenna Device에 900MHz 밴드와 1.8GHz와 1.9GHz 밴드를 동시에 적용 가능도록 패치(PCB PATTERN)형태의 구조를 다중화한 구조로 하여 하나의 안테나로 두 밴드 대역에서 사용 가능토록함을 주 요지로 하는 기술이 제시되어 있으며, 미국특허 US06002367, Planar antenna device에 개구(Aperture) 결합방식의 다중 밴드 대역에서의 적용을 위한 안테나 구조관련 기술로 동판매질의 PIFA를 적용 구조로 배열하여 구현한 기술이 제시되어 있다.

그리고 미국특허 US06072434, Aperture-coupled planar inverted-f antenna에 안테나의 방사효율을 올리기 위해서 패치(PCB PATTERN)형태의 구조를 기본으로 하여 개구 결합방식과 안테나의 전체크기를 소형화하기 위한 단락선을 부설한 방식이 제시되어 있으며, 미국특허 US5764190, Capacitively loaded PIFA에 프로브 급전의 단점인 프로브 자체가 가지는 인덕턴스를 상쇄하기 위해 프로브와 패치 간에 커패시턴스 성분을 만들어서 임피던스 특성을 향상시켜 안테나의 효율을 상승시키기 위한 기술이 제시되어 있다.

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 종래의 PIFA안테나가 RF회로와 분리된 구조에서 구성요소를 그 자체의 특수한 구조나 신호 급전 구조에 의한 특성개선이 아니라, 최근의 RF회로와 결합된 형태의 안테나 결합형 소형 RF모듈의 설계에 있어 소형화와 슬림화를 할 수 있도록, 동일 PCB모듈 내에서 접지면과 PIFA가 별도 영역에 배치되어지고 상기한 PIFA면과 접지면 사이에 유전율을 가지는 매질을 삽입하여 기존의 일반적 PIFA 사이즈보다 더욱 소형화하고 슬림화 하여 각종 PNCIA카드 형태나 휴대용 통신기기 등에 적용이 용이하도록 한 것이다.

본 발명의 구성 및 작용

본 발명은 PIFA 방식의 안테나를 구현함에 있어서, 무선 주파수(RF)신호를 증폭하고 필터링 등을 처리하는 RF신호처리부와, 상기한 RF신호처리부로부터의 고주파 신호를 안테나부로 전달을 하기 위한 적어도 한 개 이상의 급전부와, 상기한 급전부와 일정한 거리를 가지므로 인해 안테나의 특성 임피던스를 변화시킬 수 있는 단락부와, 상기한 급전부와 단락부를 결합하는 무선 주파수(RF)신호 방사를 위한 방사패치와, 상기한 방사패치의 크기와 높이를 조절하기 위해, 상기한 방사패치와 접지면 사이에 부설하는 1 이상의 유전율을 가지는 매질을 구비시킴으로써 이루어지는 것으로, 이하 본 발명을 첨부 도면에 의거 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 전체 구조로서 RF PCB 기판(300)은 4층에서 6층 정도의 다층구조를 가지며, 최상층과 최하층부 위에는 RF부품들이 배치되어지고, RF PCB 기판(300)의 내층에는 접지면과 전원층 그리고 스트림라인 등으로 구성되며, 층간 연결을 위해 비아 홀들이 배치되어 지고, 또한 RF 부품배치영역(301)에는 고주파 필터, LNA(Low Noise Amplifier), RF신호처리칩(Chip), 신호처리용 부품들이 탑재되어 구성된다.

본 발명의 안테나 방사 패치(100)는 고주파전송 효율을 주고받는 역할을 하는 주요 구성요소 이고, 급전부(101)는 RF신호를 공급하며, 단락부(102)는 방사패치와 접지면을 연결하고, 유전체 (200)는 유전율을 갖는 매질을 의미하며 공기와 같은 유전율이 1인 것일 수도 있고 특정한 값을 가지는 유전체를 적용할 수도 있다.

도 2는 PIFA의 구조와 동작을 설명하기 위한 도면으로 안테나의 변형은 역 L형 안테나에서 평면을 사용해서 대역폭을 넓힌 형태이다. 단락 마이크로스트립 안테나의 특성을 갖고 있는 아주 저지체(low-profile)형태이다. PIFA는 패치(top plate), 단락회로(short-circuit)와 접지면(ground plane)으로 구성되어 있고, 전류 급전을 통하여 패치와 접지면을 방사소자로 사용하고 있다. PIFA는 단락회로에서 패치 끝의 개방회로(open-circuit)로 구성되어 있으며, 급전점이 있는 단락회로에서 전류가 패치 끝에 개방회로 방향으로 방출되어 전류가 분포하여 방사를 하고 접지면으로 다시 되돌아와 단락회로 방향으로 전류가 분포한다.

PIFA의 공진 주파수를 결정하는 수식은 다음과 같다.

$$f_0 = \begin{cases} f_1 + (1-k)f_2 & k \leq 1 \text{의 경우} \\ f_2 + (1-k)f_1 & k > 1 \text{의 경우} \end{cases} \quad (1)$$

$$f_1 = \frac{c_0}{4(L+H)} \quad (2)$$

$$f_2 = \frac{c_0}{4(L+W+H-D)} \quad (3)$$

$$k = \frac{W}{L} \quad (4)$$

$$r = \frac{D}{W} \quad (5)$$

여기서,

c_0 : 자유공간에서 파의 속도

r : $r = 0 \sim 1$ 인 경우 공진주파수

1.2. $0 < \theta < \pi$ 인 경우 공진주파수

를 나타낸다.

PIFA의 공진 주파수를 결정짓는 파라미터는 패치의 길이 L , 폭 W , 높이 h , 단락회로의 길이 0 로 나타내는데, 폭 W 와 단락회로의 길이 0 가 같은 경우는 평면 역 L형과 같이 안테나의 높이와 길이의 합이 $\lambda/4$ 의 길이가 된다. 이는 식 (2)와 같다.

식 (3)은 단락회로의 길이 0 가 W 보다 작은 경우의 공진 주파수를 나타낸 것으로 이는 안테나의 실효율이 증가로 인해 나타난 결과이다. 결과적으로 패치의 길이와 폭이 결정된 다음 k 값이 결정된 후 식 (1)을 이용하여 안테나의 공진 주파수를 결정 할 수 있다.

안테나의 패치와 접지면 사이의 유전율을 고려하여 설계하였을 경우는 공진 주파수가 변하는데, 이는

$$f_r = f_0 \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (6)$$

로 나타낸다.

식 (6)에서 볼 수 있듯이, 유전율을 사용한 안테나의 공진 주파수 f_r 는 자유공간상에서 f_0 에 비해 공진 주파수가 낮아져 같은 공진 주파수를 갖기 위해서는 안테나의 파라미터 값을 유전율 값에 비례하여 크기를 줄여야 하는 것과 같은 주파수에서 공진 한다. 결과적으로 안테나의 크기를 더 소형화 할 수 있다. 유전율을 공기를 1로 생각해서 상용에서 사용되는 유전물질들을 사용 할 수 있다.

도 3a는 PIFA의 단락회로 길이에 따른 전류 분포를 나타낸 것이다.

PIFA 패치상의 전류분포가 나타나 있으며 안테나의 폭, 길이와 높이를 고정했을 때, 단락회로 0의 변화에 따른 실효율 분포가 다르게 나타나 안테나의 특성이 변함을 볼 수 있다.

도 3a의 (a)는 단락회로의 폭 W 와 패치의 폭 W 가 같은 경우로 패치의 전류흐름은 단락회로에서 개방회로 방향으로 적선으로 나타나고 있다. (b)는 단락 회로 길이 0 가 $W/2 < 0 < W$ 인 경우로서 (a)경우보다는 실효율 전류가 조금 더 길다. (c)는 단락회로 길이가 0가 가장 짧은 경우로 실효율은 가장 길게된다. 이때 실효율은 거의 패치의 길이 L 와 폭 W 의 합과 같아진다. 단락회로의 길이가 폭과 같은 경우보다 공진 주파수가 낮아져 더 작은 안테나를 설계 할 수 있다. 즉, 패치 실효율 길이 증가에 같은 구조에서 PIFA의 공진 주파수를 낮출 수 있어 PIFA 안테나를 소형화로 설계 할 수 있다.

도 3b는 또 다른 실시 예로 패치의 구조적인 변화를 주어서 안테나의 실효율을 더욱 확대할 수 있는 효과를 나타낸 것으로 예측된다. PIFA의 전류 흐름도에서 볼 수 있듯이 안테나의 실효율에서 가장 중요한 길이에 의해 안테나의 공진 주파수가 결정됨을 보았듯이, 패치의 가장 긴 변을 더욱 강조 할 수 있는 구조로 예상된다. 이 또한 기존의 사각 패치와 원형 패치만을 사용했던, 방법과 또 다른 형태로 기대된다. 따라서 도 3b의 두가지 실시예에서 보듯이 패치의 가장 긴 변을 중점적으로 고려하는 여러 가지 형태의 변형구조로 설계 할 수 있다.

도 4는 패치(Top-plate)상의 시간에 따른 전류분포를 한 주기를 통하여 벡터화하여 나타낸 것으로 화살표 방향은 전류의 방향과 크기를 나타낸 것이다. 초기 시간 $t = 0$ 에서 급전점에서 마가린 전류는 시간 $t = 0.2$ 가 될 때, 단락회로에서 개방회로 방향으로 향하여 흐른다. 그 후 $t = 0.4$ 에서는 거의 전류가 없다. $t = 0.6$ 과 $t = 0.8$ 에서는 다시 급전점과 단락회로 방향을 전류가 들어오는 것을 볼 수 있다. 이는 $\lambda/4$ 모노폴에서 전류흐름에 의해 안테나가 구동되는 원리와 유사함을 볼 수 있다.

도 5는 실제 제작된 PIFA의 네트워크 분석기(Network analyzer)를 통하여 측정한 실측값으로 그림 (a)는 임피던스 특성을 나타낸 것으로 Smith chart 상에서 2.44GHz에서 50 Ω (Marker 2)에 거의 패치가 밀을 볼 수 있고, 그림 (b)는 전압 정재파비(VSWR) 값으로 일반적으로 전압 정재파비는 1.60이하의 값으로 동작 할 때 만족한 값을 갖는데, 결과는 2.4GHz에서 1.59, 2.44GHz에서 1.152, 2.48GHz에서 1.5의 값을 나타내 만족한 결과가 나타났다.

도 6는 시뮬레이션에 나타난 방사 패턴을 나타낸 것으로 (a)는 수평면상 방사패턴(Azimuth plane, x-y plane)을 나타낸 것이고, (b)는 수직면상 방사패턴(Elevation plane, x-z plane)을 나타낸 것이므로 수직, 수평면과 3D 평면상에서 전, 범위에 고르게 전력이 방사되는 등방성(Isotropic)특성을 볼 수 있다.

이와 같이 유전율이 1인 공기를 적용한 포함한 PIFA구조와 더불어 더욱더 소형화가 가능한 특정 유전율을 가지는 매질을 PIFA에 채용함으로써 안테나의 크기를 더욱 소형화 할 수 있고 내장형(Built-in Type)으로 구현 가능하므로 휴대용 통신 기기나 이동통신기기에 채용이 가능하다. 따라서 ISM(Industrial, Scientific and Medical Equipment)밴드용, 고감도 소형 PIFA의 적용이 가능해지고 기존의 플러형태의 모노폴 안테나의 공간적 한계와 기계적 충격에 의한 손상을 대폭 줄일 수 있는 특성을 가지고 있다.

본 발명의 효과

근거리 디지털 통신영역의 다양한 적용사례와 더불어 시장적 요구가 확대되고 있는 상황에서 최근 ISM(Industrial, Scientific and Medical Equipment)밴드용 통신기기의 소형화에 가장 적합하게 사용할 수 있는 PIFA방식 안테나의 적용에 있어, 특정한 유전율을 가지는 매질과의 결합이나 PIFA자체의 외관 사양의 적절한 구조개선에 의해 기존방식대비 더욱 소형화하고 슬림화 할 수 있고 일반적 안테나에서 요구하는 전기적 특성면에서도 우수한 결과를 낼 수 있으며 특히 기기내에 내장(Built-in)할 수가 있으므로 종래의 모노폴 형태의 플러형 안테나가 가졌던 문제점인 파손의 위험이나 안테나부분의 공간적 한계 등을 극복할 수 있으며 최종 제품의 외관이나 디자인에 있어서도 보다 효과적인 결과를 가져 올 수 있다.

(5) 연구의 범위

청구항 1

PIFA(Planar Inverted F Antenna)방식의 안테나에 있어서,

무선 주파수(RF)신호를 증폭하고 필터링 등을 처리하는 RF신호처리부와,

상기한 RF신호처리부로 부터의 고주파 신호를 안테나부로 전달을 하기 위한 적어도 한 개 이상의 급전부와,

상기한 급전부와의 일정한 거리를 가지므로 인해 안테나의 특성, 임피던스를 변화시킬 수 있는 단락부와,

상기한 급전부와 단락부를 결합하는 무선주파수(RF)신호 방사를 위한 방사패치와,

방사패치의 크기와 높이를 줄이기 위해 상기한 방사패치와 접지면 사이에 부설하는 1 이상의 유전율을 가지는 매질로 구성되는 것을 특징으로 하는 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치.

청구항 2

청구항 1 에 있어서, 상기한 방사패치부는 접지면과의 사이에, 특정한 유전율을 가지는 매질을 부설하기 용이하도록 무선주파수(RF)부품쪽과 분리되어져 배치함으로써 독립적인 구조의 안테나구조를 가지는 것을 특징으로 하는 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치.

청구항 3

청구항 1 에 있어서, 방사패치부의 전체 면적을 줄이고 최적화 하기 위해, 심호 건류길이가 최대의 값을 가지도록 다각형 혹은 임의의 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치.

청구항 4

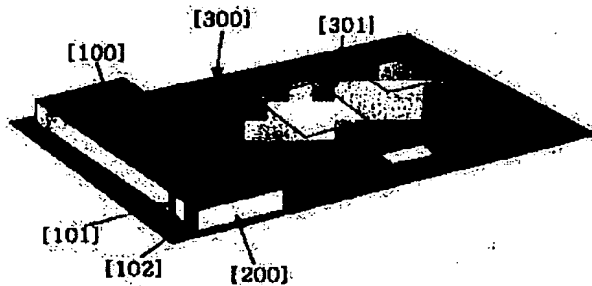
청구항 1 에 있어서, 공진주파수의 조절을 용이하게 하기 위해, 상기한 단락부를 고정하고, 상기한 단락부와 급전부와의 거리 조절이 용이한 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치.

청구항 5

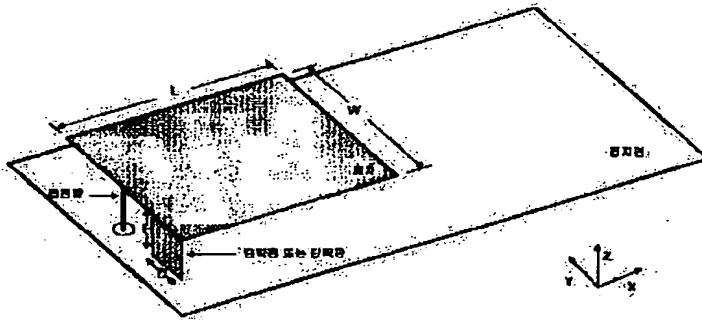
청구항 1 에 있어서, 방사패치와 단락부를 수직으로 결합시켜 무지향성의 특성을 가지게 하는 것을 특징으로 하는 유전율을 가지는 매체를 이용한 소형의 안테나 장치.

도면

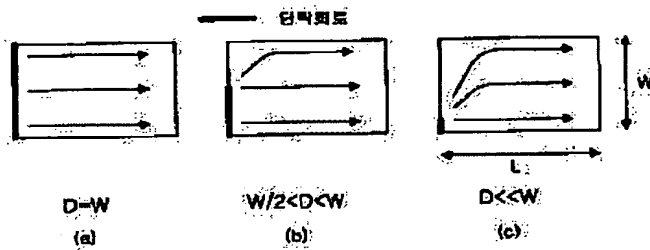
도면1



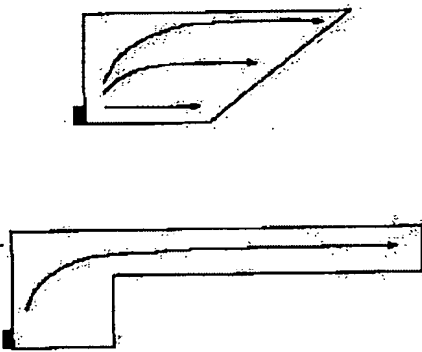
도 B2



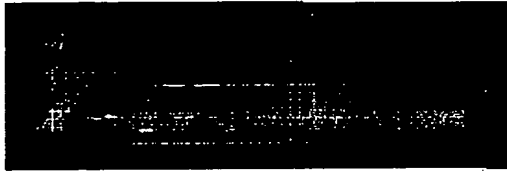
도 B3a



도 B3b



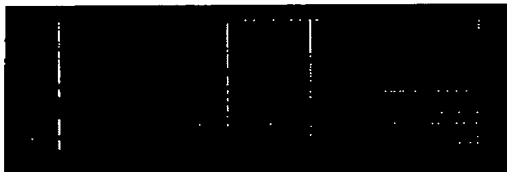
EDM



$t = 0T$



$t = 0.2T$



$t = 0.4T$

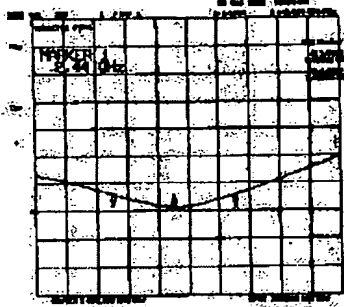


$t = 0.6T$

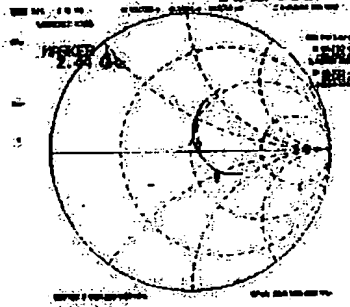


$t = 0.8T$

도 B5

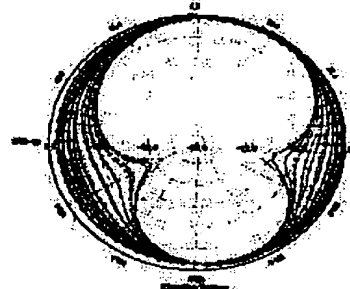
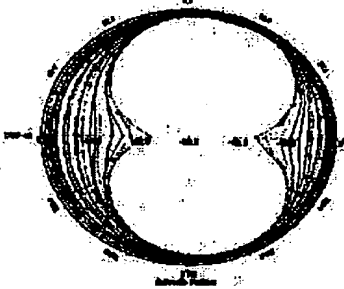


(a)



(b)

도 B8



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.